

# 銘傳大學 100 學年度轉學生招生考試

## 生物醫學工程學系、電子工程學系

### 三年級第二節

#### 「電子學」試題

(第 1 頁共 2 頁)(限用答案本作答)

可使用計算機  不可使用計算機

#### 一、選擇題(每題 2 分，共 12 分)

- pn 接面處於逆向順壓(Forward Bias)狀態時，下列敘述何者是錯的？(1) 會有一電流  $I_D$  產生，其大小和二極體的電壓  $V_D$  成指數關係 (2) 空乏區變小 (3) 會有一逆向飽和電流(Reverse saturation current)  $I_S$  產生，其值非常地小趨近於零 (4) 內建電場變小。
- 雙載子電晶體操作在主動區(Active Region)時的條件為何？(1)  $V_{BE} > 0$  且  $V_{BC} > 0$  (2)  $V_{BE} > 0$  且  $V_{BC} < 0$  (3)  $V_{BE} < 0$  且  $V_{BC} > 0$  (4)  $V_{BE} < 0$  且  $V_{BC} < 0$ 。
- 下列何者敘述是錯的？(1) BJT 會發生厄利效應(Early Effect) (2) MOSFET 會發生通道長度調變效應(Channel Length Modulation Effect) (3) BJT 有很小的基極電流  $I_B$  (4) MOSFET 的閘極電流  $I_G$  很大。
- 下列敘述何者是對的？(1) 若回授網路不為零，則整個系統稱為閉迴路(Closed-Loop)系統 (2) 正回授(Positive Feedback)是輸出訊號透過回授網路和輸入端相減 (3) 回授網路為零，則整個系統稱為閉迴路系統 (4) 負回授(Negative Feedback)是輸出訊號透過回授網路和輸入端相加。
- 有關極點(Pole)和零點(Zero)的敘述，下列何者是對的？(1) 極點和零點在波德圖(Bode's plot)上所引發的效應是一樣的 (2) 求出轉移函數(Transfer Function)  $H(s)$  分母的解，稱為零點 (3) 求出轉移函數  $H(s)$  分子的解，稱為極點 (4) 極點和零點在波德圖上所引發的效應是不一樣的。
- 負回授會使得輸入/輸出阻抗的改變，下列何者是對的？(1) 輸出阻抗變大 (2) 輸入和輸出阻抗都變小 (3) 輸入阻抗變大 (4) 輸入和輸出阻抗都變大。

#### 二、填充題(每格 2 分，共 20 分)

本試題兩面印刷

- BJT  $g_m$  的定義 = \_\_\_\_\_，計算出來的結果 = \_\_\_\_\_。 $r_\pi$  的定義 = \_\_\_\_\_，計算出來的結果 = \_\_\_\_\_。 $r_o$  的定義 = \_\_\_\_\_，計算出來的結果 = \_\_\_\_\_。
- 求一個電路的輸入阻抗  $R_{in}$  時，會在輸入端會放置一個電壓  $V_X$ ，產生一流入的電流  $I_X$ ，所以  $R_{in}$  定義為 \_\_\_\_\_。此時輸出端必須 \_\_\_\_\_。
- MOSFET 操作於三極管區(Triode Region)的條件為 \_\_\_\_\_，電流公式為 \_\_\_\_\_。

#### 三、計算與問答題(68 分)

- 如圖一所示，是橋式整流器的電路圖。利用電壓模型(二極體導通時的電壓是  $V_{D, on}$ )。(1) 請畫出其輸出  $V_{out}$  的波形(假設輸入  $V_{in}$  是弦波，峰值為  $V_p$ )，請把  $V_{in}$  和  $V_{out}$  畫在一起。(6 %) (2) 試寫出漣波電壓(Ripple voltage)  $V_R$  的公式。(4 %)
- 如圖二所示。若  $I_S = 3 \times 10^{-16} \text{ A}$ ， $\beta = 100$ ，(1) 請證明電晶體  $Q_1$  是操作在主動區。(6 %) (2) 若  $v_1$  變化 1 mV，請決定輸出信號變化多少？(6 %)

# 銘傳大學 100 學年度轉學生招生考試

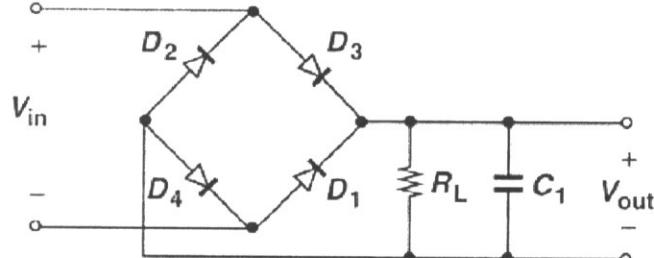
生物醫學工程學系、電子工程學系

三年級第二節

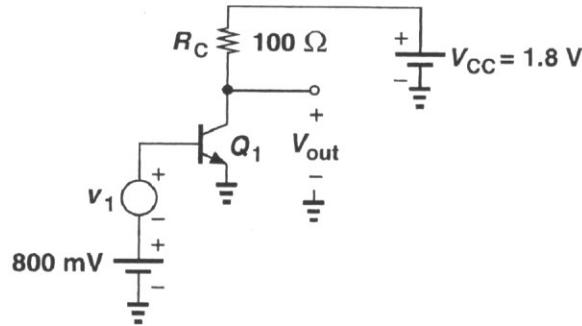
「電子學」試題

(第 2 頁共 2 頁)(限用答案本作答)

可使用計算機  不可使用計算機

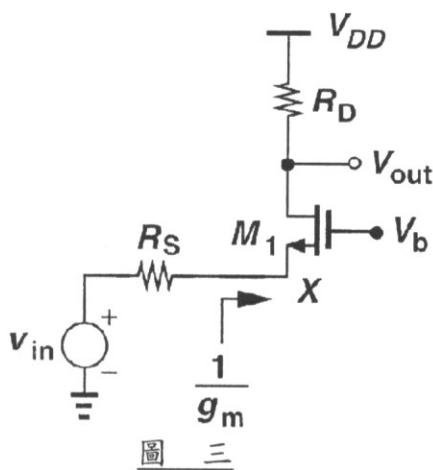


圖一

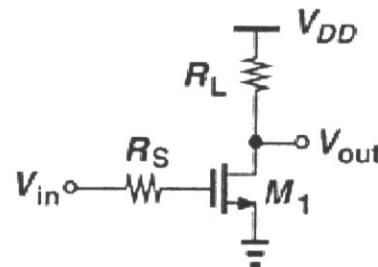


圖二

3. 如圖三所示。(1) 若  $\lambda = 0$ ，使用小信號模型求該電路的電壓增益  $A_v$ 。 (10 %) (2) 若  $\lambda \neq 0$ ，使用小信號模型求出該電路的輸出阻抗  $R_{out}$ 。 (10 %)
4. 如圖四所示， $R_S = 200 \Omega$ ， $C_{GS} = 250 \text{ fF}$ ， $C_{GD} = 80 \text{ fF}$ ， $C_{DB} = 100 \text{ fF}$ ， $g_m = (150\Omega)^{-1}$ ， $\lambda = 0$ ， $R_L = 2 \text{ k}\Omega$ 。請利用高頻小訊號模型和米勒定理推導出極點，並計算出其值。 (12 %)
5. (1) 請畫出 BJT 高頻的小訊號模型。 (7 %) (2) 請畫出 MOSFET 高頻的小訊號模型。 (7 %)



圖三



圖四

本試題由...印制

試題完